

Purificador De Gas De Laboratorio De Alta Pureza Para Atmósfera Inerte Y Gases De Proceso Ultralimpios

Número de artículo: KT-JH



Introducción

Descubra nuestro purificador de gas de laboratorio de alta pureza diseñado para el suministro continuo de gas inerte ultralimpio. Con una eliminación eficaz de humedad y oxígeno a niveles sub-ppm, este sistema garantiza la integridad absoluta de la atmósfera para exigentes instalaciones de investigación de CVD, síntesis de semiconductores y metalurgia avanzada.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Beneficio clave
Epitaxia de semiconductores y películas delgadas	Suministra gas portador de argón o nitrógeno ultra puro directamente a las cámaras de CVD, PECVD y ALD durante el procesamiento de obleas.	Previene la oxidación del sustrato, minimiza los defectos de poros (pinholes) y garantiza una alta uniformidad de la película a lo largo de delicadas capas atómicas.
Procesamiento térmico en atmósfera inerte	Purifica las corrientes de gas de protección para hornos tubulares, hornos de atmósfera de vacío y unidades de sinterizado dental que procesan aleaciones reactivas.	Elimina la descamación superficial y la descarburación en titanio, circonio y superaleaciones refractarias durante procesos de alta temperatura.
I+D de baterías de litio y estado sólido	Acondiciona atmósferas protectoras en cajas de guantes, líneas de celdas tipo pouch y estaciones de formulación de electrolitos.	Protege los ánodos de litio metálico y las composiciones de electrolito sólido sensibles a la humedad frente a la degradación catastrófica por humedad.
Fabricación de fibra óptica y fotovoltaica	Purifica la atmósfera de proceso durante el estirado de preformas, el lingotado de silicio y la deposición de capas de contacto pasivadas en obleas.	Previene las bandas de absorción de hidroxilo (OH) en el vidrio de sílice y preserva la vida útil de los portadores en células solares de alta eficiencia.
Fabricación aditiva e impresión 3D	Recircula y refina gases inertes de protección dentro de las cámaras de construcción de fusión selectiva por láser (SLM) y fusión por haz de electrones (EBM).	Mantiene niveles de oxígeno excepcionalmente bajos para evitar salpicaduras, porosidad y fragilidad en la impresión de metales reactivos.
Suministro de gas portador para instrumental analítico	Proporciona corrientes portadoras ultraestables y libres de humedad para cromatografía de gases (GC-MS), espectrometría de emisión óptica (OES) y TGA.	Reduce el ruido de fondo, previene el sangrado de la columna, prolonga la vida útil de los detectores analíticos y mejora la reproducibilidad cuantitativa.
Catálisis y síntesis de nanomateriales	Suministra atmósferas de reacción limpias durante la reducción de catalizadores, calcinación y síntesis a alta presión de nanotubos de carbono (CNT).	Elimina el envenenamiento competitivo de los sitios activos del catalizador causado por oxígeno residual e impurezas de humedad orgánica.

Parámetro de especificación	KT-JH-10	KT-JH-30	KT-JH-60	KT-JH-100
Número de artículo	KT-JH-10	KT-JH-30	KT-JH-60	KT-JH-100
Compatibilidad de gas purificado	Ar, N2, He, Kr, Ne, H2	Ar, N2, He, Kr, Ne, H2	Ar, N2, He, Kr, Ne, H2	Ar, N2, He, Kr, Ne, H2
Caudal nominal	10 L/min (0,6 m³/h)	30 L/min (1,8 m³/h)	60 L/min (3,6 m³/h)	100 L/min (6,0 m³/h)
Requisito de pureza del gas de entrada	≥ 99,99% (Grado técnico)	≥ 99,99% (Grado técnico)	≥ 99,99% (Grado técnico)	≥ 99,99% (Grado técnico)
Nivel de impureza de salida (O2)	≤ 0,05 ppm (≤ 50 ppb)	≤ 0,05 ppm (≤ 50 ppb)	≤ 0,05 ppm (≤ 50 ppb)	≤ 0,05 ppm (≤ 50 ppb)

Parámetro de especificación	KT-JH-10	KT-JH-30	KT-JH-60	KT-JH-100
Nivel de impureza de salida (H ₂ O)	≤ 0,1 ppm (Punto de rocío ≤ -90 °C)	≤ 0,1 ppm (Punto de rocío ≤ -90 °C)	≤ 0,1 ppm (Punto de rocío ≤ -90 °C)	≤ 0,1 ppm (Punto de rocío ≤ -90 °C)